

**КТ3129А9-Д9**

**PNP КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО – ПЛАНАРНЫЙ  
ТРАНЗИСТОР**

аАО.336.447ТУ/02

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В НИЗКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВАХ АППАРАТУРЫ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

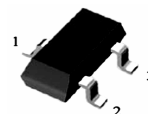
\* Зарубежные аналоги – КТ3129В9-BC857А, КТ3129В9-BC858А, КТ3129Г9-BC858В

• Изготавливается в корпусе **КТ-46А (Sot-23)**.

Диапазон рабочих температур от -60 до +85 °С

**ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Параметры	Обозначение	Единица измерения	Значение
Напряжение коллектор-база	Uкб max	В	-20-50
Напряжение коллектор-эмиттер (Rбэ=1кОМ)	Uкэг max	В	-20-40
Напряжение эмиттер-база	Uэб max	В	-5
Постоянный ток коллектора	Iк max	mA	-100
Импульсный ток коллектора	Iки max	mA	-200
Рассеиваемая мощность коллектора	Pк max	мВт	75
Температура перехода	Tj	°С	125



1. Коллектор
2. База
3. Эмиттер

**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ( Токр.ср.=25°С )**

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение коллектор-эмиттер	Uкэо гр.	В	Iк=10 мА, Iб=0	-15	-40
Обратный ток коллектора	Iкбо	мкА	Uкб=-20-50В, Iэ=0		-1,0
Статический коэффициент передачи тока	h21э		Uкб=-5В, Iэ=-2мА	30	500
Емкость коллекторного перехода	Ск	пФ	Uкб=-5В, Iэ=0, f=10МГц		12
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Uкэ нас	В	Iк=-10мА, Iб=-1мА		-0,2
Напряжение насыщения база-эмиттер	Uбэ нас	В	Iк=-10мА, Iб=-1мА		-1,3
Граничная частота коэффициента передачи тока	fгр.	МГц	Uкб=-5В, Iэ=-10мА	200	

**Классификация**

	А9	Б9	В9	Г9	Д9
Uкб max, В	50	50	30	30	20
Uкэг max, В	40	40	20	20	20
h21э	30-120	80-250	80-250	200-500	200-500

220108, г.Минск, ул. Корженевского,16 УП "Завод Транзистор"

Отдел маркетинга: тел./факс: (10-37517) 212-59-32.

E-mail: [market@transistor.com.by](mailto:market@transistor.com.by) <http://www.transistor.by>